

BAV199

硅外延平面开关二极管芯片 (4")

■用途:

*用于高压应用

■特征:

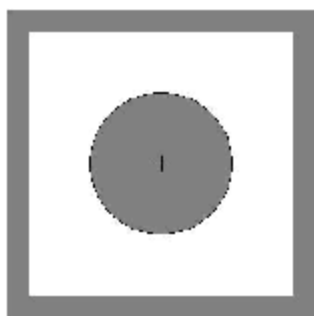
*较小结电容

*正向压降低

*用于片式封装

*有效图形数 90550 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	280 μm × 280 μm
压焊区尺寸	φ 120 μm
芯片厚度	180 ± 10 μm
锯片槽宽度	40 μm
金属层	正面: Al 2.3 ± 0.2 μm 背面: Au 1.4 ± 0.2 μm

■电特性 (Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
反向电压	V_R	$I_R=0.1mA$	70		V
正向压降	$V_F(1)$	$I_F=1mA$		0.9	V
	$V_F(2)$	$I_F=150mA$		1.2	V
反向漏电流	I_R	$V_R=70V$		5	nA
总电容	C_T	$V_R=0, f=1MHz$		2	PF
反向恢复时间	t_{rr}	$I_F=I_R=10mA, I_{rr}=0.1I_R$		3	μs

2008.4.